


Case	 TO-236			
I _c	0,1 ... 0,2A		0,5 ... 0,8A	
V _{CEO} \ Type	NPN	PNP	NPN	PNP
12V	BSV 52	SO 2894		
15V	SO 2369			
20V	BCW 31 BCW 32 BCW 33	BCW 29 BCW 30		
25V			BCX 20	BCX 18
30V	BCF 32 BCF 33	BCF 29 BCF 30	SO 2221 SO 2222 BCV 27**	BCV 26**
32V	BCW 60	BCW 61	BCW 65	BCW 67
40V			SO 2221A SO 2222A	SO 2906 SO 2907
45V	BCW 71 BCW 72 BCW 81 BCF 81 BCX 70 SO 930	BCW 69 BCW 70 BCF 70 BCX 71	BCX 19 BCW 66	BCX 17 BCW 68
50V			SO 1613* SO 1711*	
60V	SO 2484		BCV 47**	SO 2906A SO 2907A BCV 46**
65V	BCV 71 BCV 72	BCW 89		
80V		BSS 64	SO 1893	
100V	BSS 63			
120V				SO 5400
140V			SO 5550	
150V				SO 5401
160V			SO 5551	
250V	BFN 22	BFN 23		
300V	SO 642	SO 692		

BSV 52 Fast switching
Commutation rapide

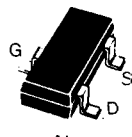
SO 2484 Low noise
Faible bruit

*V_{CER} ** Darlington

NB : Most signal transistors and diodes in our general catalog can be supplied in TO 236 case. Please, consult your nearest sales office.
La majorité des diodes et des transistors de signal de notre catalogue peut être fournie en boîtier TO236. Consulter nos services commerciaux.

n channel field effect transistors

transistors à effet de champ canal n

Types	V _{(BR) GSS}		I _{GSS}		I _{DSS}		V _{GS off}		r _{DS on}		t _{off}		C _{11SS}		C _{12SS}		Y _{21S}		F _B @ f		Marking*	Pin out
	min	max	min	max	min	max	min	max	max	max	max	max	max	max	min	max	max	max	(dB)	(MHz)		
SO 4416	30	0,1	5	15	-	6							4	0,9	4,5	7,5	4	400			FOI	
BFR 30 (R)	25	0,2	4	10	-	5							4	1,5	1	4		(1)			MI (F13)	
BFR 31 (R)	25	0,2	1	5	-	2,5							4	1,5	1,5	4,5		(1)			M2 (F14)	
SO 245 A (R)	30	5	2	6,5	-0,5	- 8							4§	1,1§	3	6,5					F 21 (F24)	
SO 245 B (R)	30	5	6	15	-0,5	- 8							4§	1,1§	3	6,5					F 12 (F20)	
SO 245 C (R)	30	5	12	25	-0,5	- 8							4§	1,1§	3	6,5					F 25 (F26)	
SO 3966	30	0,1	2		-4	- 6	220	100					9	1,5							F09 (F29)	
BSR 56	40	1	50		-4	-10	25	25						5							M4	
BSR 57	40	1	20	100	-2	- 6	40	50						5							M5	
BSR 58	40	1	8	80	-0,8	- 4	60	100						5							M6	
SO 4091 (R)	40	0,2	30		-5	-10	30	40	28	5											F02 (F22)	
SO 4092 (R)	40	0,2	15		-2	- 7	50	60	28	5											F10 (F30)	
SO 4093 (R)	40	0,2	8		-1	- 5	80	80	28	5											F11 (F31)	
SO 4391 (R)	40	0,1	50	150	-4	-10	30	35	26	4											F03 (F23)	
SO 4392 (R)	40	0,1	25	75	-2	- 5	60	55	26	4											F07 (F27)	
SO 4393 (R)	40	0,1	5	30	-0,5	- 3	100	80	26	4											F08 (F28)	
SO 5432 (R)	25	0,2	150		-4	-10	5	36	30	15											F15 (F16)	
SO 5433 (R)	25	0,2	100		-3	- 9	7	36	30	15											F17 (F18)	
SO 5434 (R)	25	0,2	30		-1	- 4	10	36	30	15											F19 (F32)	

(1) V_n (I_D = 200µA V_{DS} = 10V f = 0,6...100 Hz) : max 0,5µV

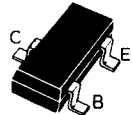
* Marking into brackets, refer to reverse pin configuration R
Marquage entre parenthèses : se référer au brochage R

§ : Typical value
Valeur typique

general purpose darlington

darlington usage général

N
N
N
N

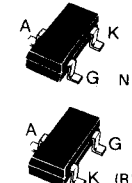
Types		Maximum ratings		Characteristics at 25°C										Marking	Pin out
NPN	PNP	P _(tot)	V _{CEO}	h _{21E}	@ I _C	V _{CE(sat)}	@ I _C /I _B	f _T	C _{22b}	F _B	t _{off}				
		(mW)	(V)	min	max	max	max	min	max	max	max				
SO 517		350	30	30K	100	1	100/1	220§	3,5§			N94			
BCV 27		350	30	20K	100	1	100/1	200§	3,5§			FD			
	BCV 26	350	30	20K	100	1	100/1	200§	3,5§			FF			
BCV 47		350	60	10K	100	1	100/1	200§	3,5§			FE			
	BCV 46	350	60	10K	100	1	100/1	200§	3,5§			FG			

§ : Typical value - Valeur typique

N : New product - Nouveau produit

thyristors

thyristors

Types	Maximum ratings					Characteristics at 25°C					Marking*	Pin out
	V _{DRM}	V _{RRM}	I _{T rms}	I _{T SM}	T _{oper}	I _{GT}	di/dt	dv/dt	t _q			
	(V)	(V)	(A)	t _p = 10 ms T _c = 25°C (A)	(°C)	T _c = 25°C max (mA)	max (A/µs)	typ (V/µs)	typ (µs)			
SO BRY 55.30(R)	30	30	0,45	4	-40 + 125	0,2	100	10	8	D 52 (D65)		
SO BRY 55.60(R)	60	60	0,45	4	-40 + 125	0,2	100	10	8	D 66 (D67)		
SO BRY 55.100(R)	100	100	0,45	4	-40 + 125	0,2	100	10	8	D 78 (D79)		
SO BRY 55.200(R)	200	200	0,45	4	-40 + 125	0,2	100	10	8	D 87 (D82)		

* Marking into brackets, refer to reverse pin configuration R.
Marquage entre parenthèses, se référer au brochage R.